

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU
CHUẨN

CHỨC DANH: Giáo sư

Mã hồ sơ:.....



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Thành Tiên

2. Ngày tháng năm sinh: 09/09/1976; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 27/3B, Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Khoa Khoa học tự nhiên, Khu 2, Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại nhà riêng: ...; Điện thoại di động: 0907851285;

E-mail: nttien@ctu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ 10/1997 đến 08/1999: Tập sự giảng dạy tại Khoa Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 09/1999 đến 12/2015: Giảng viên tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 04/2007 đến 12/2007: Phó Trưởng Bộ Môn Vật lý tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 06/2012 đến 04/2018: Phó Trưởng Khoa tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 08/2014 đến 02/2024: Phó Bí thư Đảng Bộ cơ sở Khoa tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 02/2017 đến 06/2024: Giảng viên cao cấp tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 11/2021 đến nay: Phó Trưởng Khoa tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Từ 03/2024 đến nay: Bí thư Đảng Bộ cơ sở Khoa tại Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng Khoa.

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ cơ quan: Khu 2, Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0292.3872.091

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): Không

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 20 tháng 10 năm 1997, số văn bằng: 58745, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Sư phạm

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Cần Thơ, Việt nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 31 tháng 08 năm 2004, số văn bằng: 007484, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Cần Thơ, Việt nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 06 tháng 03 năm 2012, số văn bằng: 000947, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Viện Vật lý – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày 26 tháng 10 năm 2015, ngành: Vật lý

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Cần Thơ, Hội đồng 2: Kỹ thuật, Công nghệ, Xây dựng, Kinh tế, Luật

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- **Hướng thứ nhất:** Nghiên cứu hiện tượng giam cầm điện tử của các vật liệu bán dẫn thấp chiều và nghiên cứu hiện tượng truyền dẫn hạt tải điện và hấp thụ quang với các mô hình bán cổ điển. Hướng nghiên cứu này nhằm hiểu, kiến giải các hiện tượng vi mô trong các hệ vật liệu thấp chiều lĩnh vực vi điện tử.
- **Hướng thứ hai:** Tính toán, mô phỏng sự ổn định cấu trúc, tính chất điện tử, tính chất từ, tính chất quang điện tử, hiện tượng truyền dẫn điện tử, spin điện tử (spintronic), thung lũng điện tử (valleytronics) của các vật liệu cấu trúc đơn lớp nguyên tử bằng tính toán hiệu năng cao (HPC). Hướng nghiên cứu này nhằm thiết kế, định hướng tìm kiếm các vật liệu điện tử và vật liệu quang điện mới.
- **Hướng thứ ba:** Mô phỏng linh kiện điện tử, hiện tượng hấp phụ phân tử trên các cấu trúc nano thấp chiều. Hướng nghiên cứu này nhằm định hướng phát triển linh kiện vi điện tử thế hệ mới, các sensor phân tử và khám phá thuốc mới trên nền tảng HPC.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) ... HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 6 cấp Bộ; 1 cấp Cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 54 bài báo khoa học, trong đó 35 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 5, trong đó 5 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1	Bằng khen	Ban Chấp hành Thành Đoàn TP Cần Thơ	2006
2	Bằng khen	Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo	2018
3	Bằng khen	Ban chấp hành Hội Vật Lý Việt Nam	2023
4	Chiến sĩ thi đua	Bộ Giáo dục và Đào tạo	2015
5	Chiến sĩ thi đua	Bộ Giáo dục và Đào tạo	2022
6	Nhà giáo ưu tú	Chủ tịch nước	2023

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Trong quá trình công tác, cá nhân luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các công tác khác được giao. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 24 năm 8 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1								
2								
3								
03 năm học cuối								
4	2021-2022	1		2	1	195	135	330/618.5/196
5	2022-2023	1		3	2	195	135	330/660.5/196
6	2023-2024	1		3	2	195	135	330/675.5/196

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: năm

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: Nghiên cứu Sau Tiến sĩ ở Bộ môn lý thuyết vật liệu, Khoa Vật lý và Thiên Văn, Đại học Uppsala, Thụy Điển từ 11/2015 đến 09/2016

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ C (Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 20/01/2005 số chứng chỉ: 391185)

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1	Phạm Thị Bích Thảo	X		X		03/2015 đến 02/2021	Học viện khoa học và công nghệ - Viện hàn lâm khoa học & công nghệ Việt Nam	30/06/2021

2	Trần Yên Mi	X		X		08/2019 đến 03/2023	Trường Đại học Cần Thơ	20/10/2023
---	-------------	---	--	---	--	---------------------------	---------------------------	------------

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Trước khi được công nhận PGS/TS							
1	Giáo trình Vật lý chất rắn	GT	Đại học Cần Thơ, năm 2015	2	CB		Số 1825/GXN- ĐHCT ngày 31/05/2024
Sau khi được công nhận PGS/TS							
2	Chemical Modifications of Graphene-Like Materials	CK	World Scientific, năm 2024	7	CB		Số 1827/GXN- ĐHCT ngày 31/05/2024
3	2D and 3D Graphene Nanocomposites: Fundamentals, Design, and Devices	CK	Jenny Stanford, năm 2020	5	VC	Chương 2, Trang: (47-77)	Số 1832/GXN- ĐHCT ngày 31/05/2024
4	Diverse Quasiparticle Properties of Emerging Materials: First- Principles Simulations	CK	CRC Press (Taylor & Francis), năm 2023	12	VC	Bốn chương: Trang: (49-66), (67-95), (335-348), (391-404).	Số 1833/GXN- ĐHCT ngày 31/05/2024
5	Giáo trình Vật lý tính toán	GT	Đại học Cần Thơ, năm 2021	3	CB		Số 1826/GXN- ĐHCT ngày 31/05/2024

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 1 ([2])

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Trước khi được công nhận PGS/TS					
1	Nghiên cứu một số hiệu ứng vật lý liên quan đến vận chuyển của hệ hạt tải điện hai chiều trong cấu trúc nano bán dẫn trên nền vật liệu oxit kẽm và hợp kim oxit kẽm	CN	B2010-16-167, cấp Bộ	01/01/2010 đến 31/12/2011	09/03/2012, Xuất sắc
2	Nghiên cứu hiện tượng hấp thụ quang giữa các vùng con trong các cấu trúc nano bán dẫn 2 chiều.	CN	B2012-16-12, cấp Bộ	11/06/2012 đến 10/06/2014	25/10/2014, Xuất sắc
3	Mô phỏng transistor hiệu ứng trường dây nano oxit kẽm.	CN	T2013-22, cấp Cơ sở	01/04/2013 đến 30/03/2014	19/03/2014, Tốt
Sau khi được công nhận PGS/TS					
4	Nghiên cứu độ linh động điện tử hai chiều đa vùng con và phổ hấp thụ quang trong các cấu trúc dị chất bán dẫn dựa trên các vật liệu phân cực điện	CN	B2016-TCT-03ĐT, cấp Bộ	01/11/2016 đến 31/12/2017	21/04/2018, Xuất sắc
5	Nghiên cứu các đặc tính vật lý quan trọng của hệ thấp chiều tạo bởi vật liệu Graphene và vật liệu	CN	103.01-2017.74, Nafosted, cấp Bộ	01/12/2017 đến 30/11/2019	23/11/2019, Đạt

	tựa graphene bằng phương pháp nguyên lý ban đầu				
6	Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của penta-graphene nanoribbon	CN	B2020-TCT-14, cấp Bộ	01/01/2020 đến 31/12/2021	31/03/2022, Đạt
7	Nghiên cứu tính chất điện tử và vận chuyển điện tử của các vật liệu cấu trúc nano ngũ giác	CN	103.01-2020.16, Nafosted, cấp Bộ	01/10/2020 đến 01/10/2023	19/06/2023, Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi được công nhận PGS/TS								
1	Influence of the interface roughness profile on the random piezoelectric field in a lattice mis-matched quantum well	2	Không	Communications in Physics- ISSN:0868-3166	- ACI		13, 4, 193	12/2003
2	Low temperature mobility of holes in Si/SiGe p channel heterostructure using multiple scattering.	2	Không	Communications in Physics- ISSN:0868-3166	- ACI		16, 4, 199	12/2006
3	Electron Mobility in Gaussian Heavily	3	Không	Physical Review B; ISSN:1098-0121	X - SCI IF: 3.7, Qi, H_index=497	21	77, 12, 125326	03/2008

	Doped ZnO Surface Quantum Wells							
4	Electron mobility limited by correlated donors in hydrogen-bombarded ZnO surface quantum well	3	Không	Communications in Physics, ISSN:0868-3166	- ACI		18, 2, 81	06/2008
5	Quantum confinement in Gaussian heavily-doped ZnO surface quantum well.	3	Có	Communications in Physics, ISSN:0868-3166	- ACI		18, 2, 88	06/2008
6	Electron scattering from roughness-induced fluctuations in the donor density in ZnO surface quantum wells	3	Không	Journal of Applied Physics, ISSN:0021-8979	X - SCI IF: 3.2, Q1, <i>H_index=350</i>	5	107, 12, 123709	06/2010
7	Electron scattering from polarization charges bound on a rough interface of polar heterostructures	3	Không	Journal of Applied Physics, ISSN:0021-8979	X - SCI IF: 3.2, Q1, <i>H_index=350</i>	13	109, 11, 113711	06/2011
8	Individual deduction of two roughness parameters for quantum wells from intersubband absorption peak data	2	Có	Proceedings of the 36th national conference on theoretical physics, ISSN:0868-3166			36 206	11/2011
9	Single-valued estimation of the interface profile from intersubband absorption linewidth data	4	Không	Applied Physics Letters, ISSN:0003-6951	X - SCI IF: 4.0, Q1, <i>H_index=478</i>	5	100, 11, 113103	03/2012

10	Electron distribution in AlGaIn/GaN modulation-doped heterostructures	2	Không	Communications in Physics, ISSN:0868-3166	- ACI		22, 4, 327	12/2012
11	Độ rộng vạch phổ hấp thụ tạo bởi cấu trúc giếng lượng tử AlGaAs/GaAs/AlGaAs pha tạp điều biến do tán xạ nhám bề mặt	3	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333			27 95	10/2013
12	Mô phỏng transistor hiệu ứng trường dây nano kẽm oxit	2	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333			30 20	05/2014
13	A novel approach to the evaluation of the interface roughness scattering form factor in intersubband transitions	3	Có	Journal of the Korean Physical Society, ISSN:0374-4884	X - Scopus IF: 0.6, Q3, H_index=54		64, 11, 1713	06/2014
Sau khi được công nhận PGS/TS								
14	Electron distribution in polar heterojunctions within a realistic model	4	Có	Physica B, ISSN:0921-4526	X - SCI IF: 2.8, Q2, H_index=130	4	479 62	12/2015
15	Key scattering mechanisms limiting the lateral transport in a modulation-doped polar heterojunction	4	Có	Journal of Applied Physics, ISSN:0021-8979	X - SCI IF: 3.2, Q1, H_index=350	15	119, 21, 214304	06/2016
16	One-sample based single-valued estimation of the interface profile from	4	Không	Journal of the Physical Society of Japan, ISSN:0031-9015	X - SCI IF: 1.7, Q2, H_index=143	2	84 074603	06/2016

	intersubband integrated absorption intensity data							
17	Mô phỏng trạng thái điện tử và phổ hấp thụ của các chấm lượng tử có hình dạng khác nhau.	2	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333			47 98	12/2016
18	Linear intersubband optical absorption in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN under a uniform electric field.	4	Có	Physica B, ISSN:0921-4526	X - SCI IF: 2.8, Q2, H_index=130	16	519 63	08/2017
19	Tính chất điện tử của cấu trúc siêu mạng dựa trên dây dị chất ZnO/GaN kiểu armchair	4	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333			52 22	10/2017
20	Tuning electronic transport properties of zigzag graphene nanoribbons with stone-wales defect	4	Có	Communications in Physics, ISSN:0868-3166	- ACI		28, 3, 201	11/2018
21	Polar charges effect on multisubband electron mobility in the semiparabolic quantum wells based on AlN/AlGaN/AlN.	4	Không	Journal of Physics: Conference Series, ISSN:1742-6588	X - Scopus IF: 0.48, Q4, H_index=99		1034 012007	12/2018
22	Diverse electronic and magnetic properties of	4	Không	Scientific Report, ISSN:2045-2322	X - SCI IF: 4.6, Q1, H_index=315	32	8 17859	12/2018

	chlorination-related graphene nanoribbons							
23	Tuning electronic transport properties of zigzag graphene nanoribbons with silicon doping and phosphorus passivation.	3	Có	AIP advances, ISSN:2158-3226	X - SCI IF: 1.6, Q2, H_index=81	16	8 085123	08/2018
24	Electronic transport in the V - shaped edge distorted zigzag graphene nanoribbons with substitutional doping.	5	Có	Advances in Condensed Matter Physics, ISSN:1687-8108	X - Scopus IF: 1.3, Q3, H_index=32	10	4715953	02/2019
25	Nanomechanical and material properties of fluorine-doped tin oxide thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis: effects of F-doping.	4	Không	Materials. ISSN:1996-1944	X - SCIE IF: 3.4, Q2, H_index=168	51	12, 10, 1665	05/2019
26	Electronic and transport features of sawtooth penta-graphene nanoribbons via substitutional doping.	4	Có	Physica E, ISSN:1386-9477	X - SCI IF: 3.3, Q2, H_index=112	45	114 113572	10/2019
27	Adsorption of gas molecules on penta-graphene nanoribbon and its implication for nanoscale gas sensor	3	Có	Physics Open, ISSN:2666-0326	X - Scopus IF: Q3, H_index=11	35	2 100014	03/2020

28	The electronic properties and electron transport of sawtooth penta-graphene nanoribbon under uniaxial strain: ab-initio study	3	Có	Philosophical magazine, ISSN: 1478-6435	X - SCI IF: 1.7, Q2, <i>H_index=125</i>	16	100 1834	03/2020
29	Influence of edge termination on the electronic and transport properties of sawtooth penta-graphene nanoribbons	4	Có	Journal of Physics and Chemistry of Solids, ISSN: 0022-3697	X - SCI IF: 3.99, Q2, <i>H_index=121</i>	36	146 109528	11/2020
30	Nghiên cứu khả năng gắn kết với rotigotine của cluster vàng Au₆ bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ.	4	Không	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333			51, 1, 56	03/2021
31	Diverse structural and electronic properties of pentagonal SiC₂ nanoribbons: a first-principles study	4	Có	Materials Today Communications, ISSN: 2352-4928	X - SCIE IF: 3.38, Q2, <i>H_index=55</i>	17	26 102047	03/2021
32	Theoretical study of the binding of the thiol-containing cysteine amino acid to the silver surface using a cluster model	4	Không	The journal of physical chemistry A, ISSN:1089-5639	X - SCI IF: 2.78, Q2, <i>H_index=257</i>	15	125, 16, 3244	04/2021
33	An ab initio study of small gas molecule adsorption on the edge of n-doped sawtooth penta-graphene nanoribbons	3	Có	Papers in Physics, ISSN:1852-4249	X - ESCI IF: Q4, <i>H_index=12</i>		13 130003	05/2021

34	Investigation on electronic and optical properties of the vacancy penta-graphene nanoribbons	6	Có	1st international conference of physics, ISBN: 978-625-7720-56-4				08/2021
35	Electronic, magnetic and spin-polarized transport properties of the zigzag-zigzag penta-graphene nanoribbon	3	Có	Communications in Physics, ISSN:0868-3166	- ACI		31, 4, 389	09/2021
36	First-principles study of electronic and optical properties of defective sawtooth penta-graphene nanoribbons.	4	Có	Computational Materials Science, ISSN:0927-0256	X - SCI IF: 3.3, Q1, H_index=145	19	203 111065	02/2022
37	Cơ chế hấp phụ và sự tăng cường hóa học phổ SERS của mercaptopurine và thioguanine trên bề mặt Au₆ cluster.	5	Không	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333			58 111	04/2022
38	A comparison study of the structural, electronic and electronic transport properties of nanoribbons based on penta-graphene, penta-P2C and penta-SiC2.	3	Có	Materials Today Communications, ISSN: 2352-4928	X - SCIE IF: 3.38, Q2, H_index=55	3	32 103912	06/2022
39	First-principles study of electronic and optical properties of small edge-	4	Có	AIP advances, ISSN:2158-3226	X - SCI IF: 1.6, Q2, H_index=81	12	12 065008	06/2022

	functionalized penta-graphene quantum dots.							
40	Opto-electronic properties of small ZnO₂ nanoparticles: first-principles insights.	3	Có	Communications in Physics, ISSN:0868-3166	- ACI		32, 4, 423	07/2022
41	Effect of phosphorus doping positions on electronic transport properties in the sawtooth penta-graphene nanoribbon-first-principles insights.	4	Có	Solid State Communications, ISSN: 0038-1098	X - SCI IF: 1.6, Q2, H_index=142	3	353 114859	09/2022
42	Insights on modulating electronic and transport properties of the sawtooth-sawtooth penta-SiC₂ nanoribbons under uniaxial small strain by first-principles calculations.	4	Có	AIP advances, ISSN:2158-3226	X - SCI IF: 1.6, Q2, H_index=81	2	12 095318	09/2022
43	Structural and electronic properties of hydrogen - functionalized armchair germanene nanoribbons: a first-principles study	3	Không	Can Tho University Journal of Science, ISSN:2615-9422	- ACI		14, 3, 25	11/2022
44	Structural diversity and optoelectronic properties of chemical	5	Có	Journal of Physics: Conference	X - Scopus IF: 0.48, Q4		2485 012002	11/2022

	modification pentagonal quantum dots			Series, ISSN:1742-6588				
45	Structural, magneto-electronic, and electric transport properties of pentagonal PdSe2 nanoribbons: a first-principles study.	3	Có	Surface Science. ISSN:0039-6028	X - SCIE IF: 1.9, Q2, H_index=159	4	728 122206	02/2023
46	Insights into Structural, Electronic, and Transport Properties of Pentagonal PdSe2 Nanotubes Using First-Principles Calculations	5	Có	Nanomaterials. ISSN:2079-4991	X - SCIE IF: 5.0, Q1, H_index=126	3	13, 11, 1728	05/2023
47	Electronic transport properties of doped sawtooth - sawtooth penta silicon dicarbide nanoribbons	4	Không	Science & Technology Development Journal: Natural Science, ISSN:2588-106X			7, 1, 2560	05/2023
48	Strain-controlled electronic transport and exciton radiative lifetime in monolayer germanium sulfide	7	Có	Physical Review B, ISSN:1098- 0121	X - SCI IF: 3.7, Q1, H_index=497	3	108, 20, 205406	11/2023
49	From hexagonal to rocksalt structure: A computational study of gallium selenide under hydrostatic pressure	5	Không	Physical Review B, ISSN:1098- 0121	X - SCI IF: 3.7, Q1, H_index=497		108, 20, 2015150	11/2023

50	Symmetry-driven valleytronics in the single-layer tin chalcogenides SnS and SnSe	4	Có	Physical Review B, ISSN:1098-0121	X - SCI IF: 3.7, Q1, H_index=497	109, 15, 155416	04/2024
51	Rich essential properties of silicon-substituted graphene nanoribbons: a comprehensive computational study	6	Không	Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN: 1463-9076	X - SCI IF: 3.67, Q2, H_index=290	26 15939	04/2024
52	Nghiên cứu mô phỏng tính chất quang điện tử của các chấm lượng tử dựa trên vật liệu PdSe₂ đơn lớp dạng ngũ giác pha tạp đơn và đôi nguyên tử	5	Có	Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, ISSN:1859-2333		60, 2A, 41	04/2024
53	Adsorption effects of acetone and acetonitrile on defected penta-PdSe₂ nanoribbons: a DFT study	6	Có	RSC Advanced, ISSN:2046-2069	X - SCIE IF: 3.9, Q1, H_index=210	14, 23, 16445	05/2024
54	A systematic investigation of chromium and vanadium impurities in Janus Ga₂SO monolayer towards spintronic applications	4	Không	Physical Chemistry Chemical Physics, ISSN: 1463-9076	X - SCI IF: 3.67, Q2, H_index=290	Advance	06/2024

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: **22** ([14] [15] [18] [23] [24] [26] [27] [28] [29] [31] [33] [36] [38] [39] [41] [42] [44] [45] [46] [48] [50] [53])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán	Tham gia	Số 283/QĐ-ĐHCT ngày 09/02/2017 của Hiệu Trưởng	Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại	Quyết định số 1439/QĐ-ĐHCT ngày 08/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học	Tham gia xây dựng, chủ trì thẩm định

			Trường Đại học Cần Thơ	học Cần Thơ	Cần Thơ và Quyết định số 2493/QĐ-BGDĐT ngày 05/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo	
2	Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán	Chủ trì	Số 5161/QĐ-ĐHCT ngày 29/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ	Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ	Quyết định ban hành chương trình số 879/QĐ-ĐHCT ngày 31/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ	Thực hiện theo hai thông tư số I7/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 và số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ giáo dục và Đào tạo
3	Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành vật lý lý thuyết và vật lý toán	Tham gia	Số 1171/QĐ-ĐHCT ngày 04/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ	Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ	Quyết định ban hành chương trình số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ	Điều chỉnh chương trình theo chu kỳ quy định
4	Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn	Tham gia	Số 6256/QĐ-ĐHCT ngày 13/11/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ	Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ	Quyết định ban hành chương trình số 359/QĐ-ĐHCT ngày 29/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ	Giảng viên cơ hữu chịu trách nhiệm mở chuyên ngành, xây dựng đề cương môn học

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng): Trên 3 năm

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): Trên 6 năm

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Đủ giờ chuẩn dạy trực tiếp

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Đủ giờ chuẩn quy đổi

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: Hướng dẫn đủ NCS

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: Chủ trì đủ đề tài

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: Công bố đủ công trình khoa học

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: Đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: Đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo.

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2024

Người đăng ký

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thiên', is written over a horizontal blue line.

Nguyễn Thành Tiên